

# 2SD856, 2SD856A

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形 / Si NPN Triple Diffused Planar

電力増幅用 / Power Amplifier

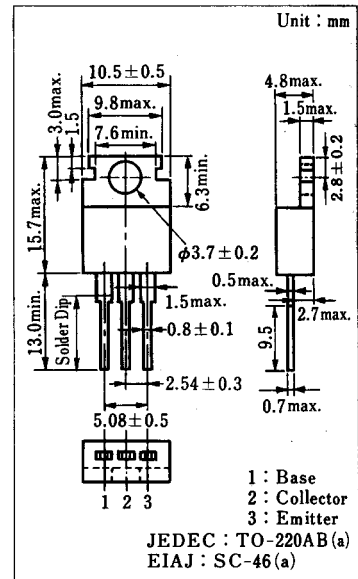
2SB761, 2SB761A とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SB761, 2SB761A

### ■ 特徴 / Features

- 直流電流幅率  $h_{FE}$  が大きく、直線性がよい。 / High  $h_{FE}$  and good linearity
- コレクタ・エミッタ飽和電圧  $V_{CE(sat)}$  が低い。 / Low  $V_{CE(sat)}$

### ■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	60	V
2SD856A		80	
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	60	V
2SD856A		80	
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	6	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	5	A
コレクタ電流	$I_C$	3	A
コレクタ損失 (Tc = 25 °C)	$P_C$	35	W
接合部温度	$T_j$	150	°C
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	°C



### ■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Tc = 25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ シャ断電流	2SD856	$V_{CE} = 60\text{ V}, V_{BE} = 0$			200	$\mu\text{A}$
	2SD856A	$V_{CE} = 80\text{ V}, V_{BE} = 0$			200	
コレクタ シャ断電流	2SD856	$V_{CE} = 30\text{ V}, I_B = 0$			300	$\mu\text{A}$
	2SD856A	$V_{CE} = 60\text{ V}, I_B = 0$			300	
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 6\text{ V}, I_C = 0$			1	mA
コレクタ・ エミッタ電圧	2SD856	$I_C = 30\text{ mA}, I_B = 0$	60			V
	2SD856A		80			
直流電流増幅率	$h_{FE1}^*$	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 1\text{ A}$	40		250	
		$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 3\text{ A}$	10			
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 3\text{ A}$			1.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 3\text{ A}, I_B = 0.375\text{ A}$			1.2	V
ターンオン時間	$t_{on}$	$I_C = 1\text{ A}, I_{B1} = 0.1\text{ A}, I_{B2} = -0.1\text{ A}$		0.5		$\mu\text{s}$
ターンオフ時間	$t_{off}$			3		$\mu\text{s}$

\* $h_{FE1}$  ランク分類 /  $h_{FE1}$  Classifications

Class	R	Q	P
$h_{FE1}$	40 ~ 90	70 ~ 150	120 ~ 250